	Справ. № Перв. застосув.			
Поз. позначення	H	айменування	Кіл.	Примітки
	3			,
	<u>K</u>	онденсатори		
C1-C3	C-0805 50 B 1vrΦ 109	% X7R Hitano	3	
	<u> </u>	<u>Мікросхеми</u>		
DA1	КР1014КТ1А Электрон	ика и связь	1	
DD1	74HC860 Philips		1	
DD2	74HCT74PW NXP		1	
DD3	CD74ACO2M96 TI		1	
DD4	SN74HC10QDREP Texas	s Instruments	1	
DD5,DD6	TC74AC04F Toshiba		2	
DD7	SN74HC10QDREP Texas	: Instruments	1	
DD8,DD9	74AC191SC Fairchild		2	
DD 10	CD4061A NXP		1	
DD11	SN74HC10QDREP Texas	s Instruments	1	
DD12,DD13	74AC191SC Fairchild		2	
DD14	SN74HC10QDREP Texas	Instruments	1	
		<i>Резистори</i>		
R1	R-0805 0,125 Bm 390	кОм 5 % Hitano	1	
R2	R-0805 0,125 Bm 433,5	5 кОм 5 % Hitano	1	

Зм.	Арк.	№ док	IIM	Підп.	Дата		ДК82.469338.001 ПЕЗ					
Posp		Ниш Е. Р.	_	7 11011.	дини	Захист телефона від		Лim.	Аркцш	Аркцшів		
Пері			7 <i>l.O.</i>] J	•			1	2	
Ция							חוֹם חוֹם		КПІ ім. І.Сікорського,			
Зап	энтр. эв.	Губар В.І	Губар В.Г.			Перелік елементів		ФЕЛ, КЕОА, ДК-82				
			•									
Інв. № подл.			Підп. т	а дата		Взам. інв. №	Інв. № дубл.	Підп. та дал		ата		

Поз. позначення	Наймен	ування	Ki	іл. Примітки	
R3	R-0805 0,125 Bm 76,5 k0m 5	;	1		
R4	R-0805 0,125 Bm 39 k0m 5 5	;	1		
R5	R-0805 0,125 Bm 100 k0m 5	;	1		
R6,R7	R-0805 0,125 Bm 82 k0m 5	2	?		
R8-R10	R-0805 0,125 Bm 100 k0m 5	% Hitano	j	3	
	<u>Діо</u> .	<u>đu</u>			
VD1, VD2	BZX384 NXP		2	?	
VD3-VD7	1N4148W Yangjie		1	5	
	<u>Транзи</u> .	стори			
VT1	BC856B Infineon			1	
V / /	טבטטט ווווווופטוו		,	/	
	<u>Po3'a</u>				
XP1-XP3	PLS-2 Ningbo Zhenqin Electr		3		
<u> </u>					
Зм. Арк.	№ докум. Підп. Дата	ДК82.40	6 <i>9338.0</i> 0	01 NE3	Арк. 2
Í					
Інв. № па	одл. Підп. та дата	Взам. інв. №	Інв. № дубл.	Підп. та дата	